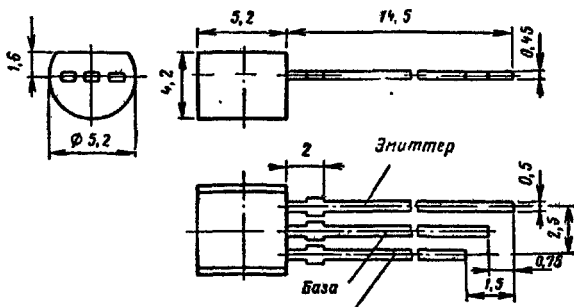


КТ351А, КТ351Б

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *p-n-p* у-сальные. Предназначены для применения в усилителях высокой частоты и ключающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. На корпусе наносится условная маркировка двумя цветными точками: КТ351А — желтой и розовой, КТ351Б — двумя желтыми.

Масса транзистора не более 0,3 г.

КТ351 (А, Б)



Электрические параметры

Коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при

$U_{\text{кв}} = 1 \text{ В}$, $I_{\text{б}} = 300 \text{ мА}$

$T = +25 \text{ }^\circ\text{C}$

КТ351А

КТ351Б

$T = -40 \text{ }^\circ\text{C}$ не менее

$T = +85 \text{ }^\circ\text{C}$

20, 52* 80

50 70* 200

0,4 значения при

$T = +25 \text{ }^\circ\text{C}$

От 0,9 до 2 значений при $T =$

$T = +25 \text{ }^\circ\text{C}$

Частота коэффициента передачи тока при

$U_{\text{кв}} = 5 \text{ В}$, $I_{\text{б}} = 10 \text{ мА}$, не менее

ипсовое значение

Максимальное значение насыщения коллектор — эмиттер при $I_{\text{к}} =$

$I_{\text{б}} = 50 \text{ мА}$ КТ351А, не более

ипсовое значение

$I_{\text{б}} = 10 \text{ мА}$, КТ351Б, не более

ипсовое значение

Максимальное значение насыщения база — эмиттер при $I_{\text{к}} = 400 \text{ мА}$

$I_{\text{б}} = 50 \text{ мА}$ КТ351А, не более

ипсовое значение

$I_{\text{б}} = 10 \text{ мА}$ КТ351Б, не более

ипсовое значение

Максимальный ток коллектора при $U_{\text{кв}} = 10 \text{ В}$, не более:

$T = +25 \text{ }^\circ\text{C}$

$T = +85 \text{ }^\circ\text{C}$

Максимальный ток эмиттера при $U_{\text{эб}} = 4 \text{ В}$, не более

Максимальная скорость коллекторного перехода при $U_{\text{кв}} = 5 \text{ В}$, не более

ипсовое значение

Максимальная скорость эмиттерного перехода при $U_{\text{эб}} = 1 \text{ В}$, не более

ипсовое значение

200 МГц

430* МГц

0,6 В

0,35* В

0,9 В

0,46* В

1,2 В

0,9* В

1,1 В

0,89* В

1 мкА

15 мкА

10 мкА

20 пФ

9* пФ

30 пФ

20* пФ

Предельные эксплуатационные данные

Максимальное напряжение коллектор — база

20 В

Максимальное напряжение коллектор — эмиттер при $R_{\text{эб}} \leq$

кОм

15 В

Максимальное напряжение эмиттер — база

5 В

Максимальный ток коллектора при $t_{\text{к}} \leq 1 \text{ мс}$, $Q \geq 10$

400 мА

Максимальная рассеиваемая мощность коллектора¹

$T \leq +30 \text{ }^\circ\text{C}$

300 мВт

$T = +85 \text{ }^\circ\text{C}$

162,5 мВт

Максимальное сопротивление переход — среда

0,4 $^\circ\text{C}/\text{мВт}$

Температура *p-n* перехода

$\pm 150 \text{ }^\circ\text{C}$

Температура окружающей среды

$-40 \text{ }^\circ\text{C} \text{ } +85 \text{ }^\circ\text{C}$

¹ В диапазоне температур $+30 \text{ }^\circ\text{C} \text{ } +85 \text{ }^\circ\text{C}$ допустимое значение рассеиваемой мощности определяется линейно

Гибкие выводы допускаются не ближе 5 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5..2 мм

Минимально допустимое расстояние от места пайки выводов до корпуса при температуре не выше $+250 \text{ }^\circ\text{C}$ и длительности не более 10 с. Температура корпуса при пайке не должна превышать $+150 \text{ }^\circ\text{C}$